

# 設計例レポート

タイトル	HiperLCS <sup>™</sup> LCS700HG を使用した 100 W、 低背型 (11 mm)、LLC DC-DC コンバータ		
仕様	380 VDC 入力; 24 V、3 A; 12 V、2.32 A 出力		
用途	LCD TV		
作成者	アプリケーション技術部門		
ドキュメント番号	DER-282		
日付	2011年9月13日		
改訂	1.2		

### 概要と機能

- 極めて少ない部品点数
  - 部品点数が少なく小型で高集積化されたソリューション
  - 低コストの SMD (D-PAK) 出力ダイオードにより、ヒートシンク及び実装のコストを削減
- 高い動作周波数 (270 kHz) による、小型化及び低コスト化
  - セラミック出力コンデンサの使用が可能
  - トランスのサイズを削減し、低背型 EFD30 トランスを使用
  - バーストモードにより無負荷時レギュレーションを改善
- 高効率
  - 負荷 100% 時の効率 94% 以上、負荷 50% 時の効率 93% 以上
  - コンデンサによる低消費電力電流センス

#### 特許情報

ここで提示した製品及びアプリケーション (製品の外付け周辺回路及びトランス構造も含む) は、米国及び他国の特許の対象である場合があります。また、Power Integrations に譲渡された米国及び他国の出願中特許の対象である場合があります。Power Integrations の持つ特許の全リストは、www.powerint.com に掲載されます。Power Integrations は、<a href="http://www.powerint.com/ip.htm">http://www.powerint.com/ip.htm</a> に定めるところに従って、特定の特許権に基づくライセンスを顧客に許諾します。

目次		
1	重要な注意点	4
2	はじめに	5
3	電源仕様	7
4	回路図	8
5	回路の説明	9
5.1	一次側	9
5.2	出力整流	11
6	PCB レイアウト	12
7	部品表	13
8	トランスの仕様	15
8.1	回路図	15
8.2	電気仕様	15
8.3	材料	15
8.4	トランスの構造図	
8.5	ボビン – ピン番号	16
8.6	トランス構造	17
8.7	巻線の図	
9	出カインダクタの仕様	_
9.1	電気仕様	
9.2	材料リスト	
10	LLC 共振コンバータ設計計算シート	
11	ヒートシンク アセンブリ	
12	性能データ	
12.1	効率性 - 100%、50%、20%、及び 10% の負荷	
	効率データ	
12.2		
	クロス レギュレーション データ	
12.3		
13	波形	
13.1	通常動作時のハーフブリッジ電圧とハーフブリッジ電流	
	380 VDC 入力で測定	
13.2	出力電圧起動プロファイル	
13.3	負荷過渡応答 (380 VDC 入力時に 5% から 100% の負荷)	
13.4	出力停止	36
13.5	出力ダイオード ピーク逆電圧	
13.6	短絡	
13.7		
	リップルの測定方法	
13.7.2	? 出力リップルの測定結果	39



14	温度測定	40
	条件:380 VDC、最大負荷、1 時間動作	
	改訂履歴	

## 重要な注意点:

この基板は絶縁に関する安全要件を満たすよう設計されていますが、評価プロトタイプは機関の 承認を得られていません。また、トランスには一次側からコア、及び二次側へのスペースまでを 満たす適切なシュラウドが必要です。

# 1 重要な注意点

このボードを正常に動作させるには、+380 V の入力と入力リターンの両端子間に、10 μF 以上の整流コンデンサを接続する必要があります。

このボードには 12 V のバイアス電源を外部接続して動作させる必要があります。15 V を超える電圧を印加しないでください。IC が損傷します。

この電源には、短絡保護はありますが、出力過電圧保護は実装されていません。TL431 (U3) またはフォトカプラ (U2) を停止させて過電圧テストを行うと、出力電圧が大きく上昇して、出力ショットキー ダイオード (D2-D3) がブレークダウンし、破損します。このため、このテストは過電圧保護回路を追加せずに実行しないでください。

バースト モード機能では、通常、軽負荷条件及び高入力電圧条件で、出力にわずかに高いリップル電圧が生じる場合があります。この設計には、LCS700HG の バースト モード -2<sup>1</sup> が選択されています。

ソフトスタートの性能は、該当する仕様に応じてコンデンサ C3 の適切な値を選択することにより最適化できます。

この設計では、表面実装ショットキーダイオード整流器を使用します。この設計を引用するためには、電圧のディレーティング条件を慎重に評価する必要があります。ディレーティング条件次第では、より高い定格を持つ部品に置き換えることも必要です。

<sup>「</sup>バースト モードの動作の詳細については、HiperLCS のデータ シートを参照してください。



\_

#### はじめに 2

このドキュメントは、LLC 制御/電力部を内蔵した LCS700HG を使用した、12 V / 24 V、100 W LLC DC-DC 共振コンバータに関する技術レポートです。この電源は、LED バック ライトを備え た LCD TV で使用されることを想定しています。このボードにも +12 VDC 及び +380 VDC 入 力が必要です。

このドキュメントには、電源仕様書、回路図、部品表、トランス資料、基板レイアウト、及び性能 データが記載されています。



図1-実装基板の写真、上面図(長さ:136.27 mm x 幅:79.88 mm)

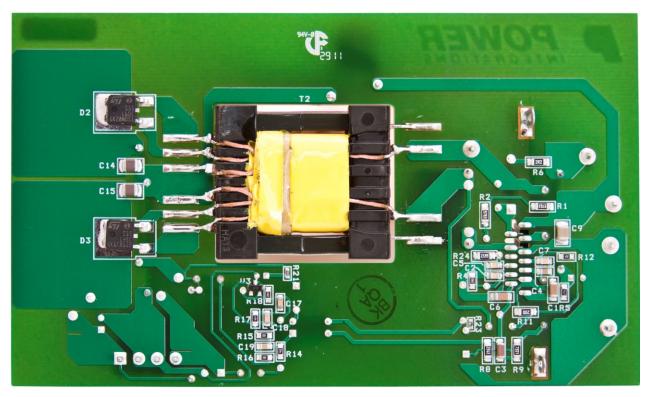


図2-実装基板の写真、底面図

#### 3 電源仕様

次の表は、設計上の最小許容性能を示しています。実際の性能は、性能データセクションを参 照してください。

概要	記号	最小	標準	最大	単位	コメント
入力						
電圧	$V_{IN}$	300	380	420	VDC	DC 入力のみ
出力						
出力電圧 1	$V_{OUT1}$	11.4	12	12.6	V	±5%
出力 P-P リップル電圧 1	$V_{RIPPLE1}$			120	mV	20 MHz バンド幅
出力電流 1	I <sub>OUT1</sub>	0.01	2.33	3.00	Α	両方の出力の合計負荷 100 W 以下
出力電圧 2	$V_{OUT2}$	22.8	24	25.2	V	±5%
出力 P-P リップル電圧 2	V <sub>RIPPLE2</sub>			240	mV	20 MHz バンド幅
出力電流 2	I <sub>OUT2</sub>	0.01	3.00	3.00	Α	両方の出力の合計負荷 100 W 以下
出力電力の合計						
連続出力電力	P <sub>OUT</sub>			100	W	
ピーク出力電力	P <sub>OUT_PEAK</sub>			100	W	
効率						
負荷 20%	η	89.5	90		%	DC-DC コンバータ目標効率、 25 °C、380 VDC 入力で測定
負荷 50%	η	93.3	94		%	DC-DC コンバータ目標効率、 25°C、380 VDC 入力で測定
負荷 100%	η	94	94.5		%	DC-DC コンバータ目標効率、 25 °C、380 VDC 入力で測定

# 4 回路図

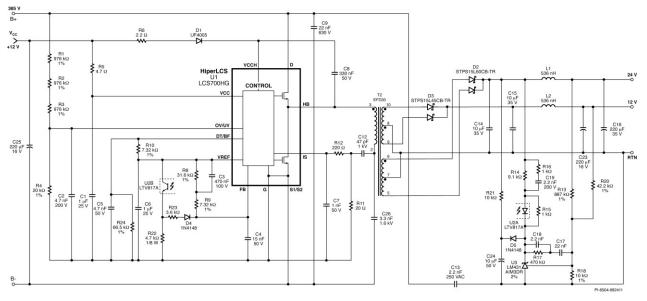


図 3 - 回路図

### 5 回路の説明

図 3 の回路図は、LCD TV アプリケーションでの使用を想定し、LCS700HG デバイスを実装した 12 V / 24 V、100 W LLC DC-DC コンバータを示しています。この回路が動作するには、 +12 V 及び +380 V の入力電源が必要です。

正常に動作させるには、+380 V の入力と入力リターンの両端子間に、10 μF 以上の整流コンデンサを直接配置した基板を使用する必要があります。

12 V 入力に 15 V を超える電圧を印加しないでください。IC が損傷します。

### 5.1 一次側

集積回路 U1 には、LLC 共振ハーフブリッジ コンバータに必要な制御回路、ドライバ、出力デバイスが内蔵されています。U1 の HB 出力ピンはブロッキング/共振コンデンサ (C26) 経由で出力トランス T2 を駆動します。このコンデンサの定格は、動作リップル電流に対応し、電圧定格は、異常状態時の電圧に耐えるように選択する必要があります。コンデンサ C26 はこれらすべての要件を満たします。

トランス T2 は漏れインダクタンスを 100 μH として設計されました。この値と共振コンデンサ C26 の値から、以下の方程式に基づき一次直列共振周波数が 280 kHz 以下に設定されます。

$$f_R = \frac{1}{6.28\sqrt{L_L \times C_R}}$$

この方程式の  $f_R$  は直列共振周波数 (単位ヘルツ) です。 $L_L$  はトランスの漏れインダクタンス (単位ヘンリー) です。そして、 $C_R$  は、共振コンデンサ (C26) の値 (単位ファラッド) です。

トランスの巻線比は、最大負荷時の定格入力電圧の動作周波数が前述の共振周波数をわずかに下回るように一次巻線を調整することによって設定されました。また、二次巻線は、コア損失と銅損のバランスを考慮して選択されました。一次巻線及び二次巻線には AWG #42 リッツ線が使用されました。この巻線ゲージにより 270 kHz 以下での効率が向上します。それぞれの巻線本数 (ストランド数) は、巻線枠と銅損のバランスをとって選択されました。コア材料はFerroxcube 3F3 で、これは高周波動作に最適です。TDK PC95 も適切に動作します。270 kHzの動作周波数は、トランスのサイズ、出力フィルタコンデンサ、及び効率の最もバランスのとれた値です。

部品 D1、R6、及び C8 は、ブートストラップ回路を構成して、U1 のトップ サイド ドライバを供給します。 部品 R5 及び C1 は、+12 V 入力をフィルタ及びバイパスします。 分圧器 R1 ~ R4 は U1 の高電圧ターンオンと過電圧スレッシュホールドを設定します。 分圧器の値は、定格入力過電圧 473 VDC で、LLC ターンオン スレッシュホールドが 360 VDC、ターンオフ スレッシュホールドが 285 VDC となるように選択されています。

www.powerint.com

コンデンサ C9 は、+380 V 入力の高周波バイパス コンデンサです。

コンデンサ C12 は、C26 とともに電流分割器を形成します。C12 は、一次電流の一部をサンプリングするのに使用されます。抵抗 R11 がこの電流を検出します。結果として生じた信号は、R12 と C7 によってフィルタされます。コンデンサ C12 の定格は、異常状態時のピーク電流に対応する必要があります。また、C12 には、フィルム、NPO/COG セラミックなどの安定した低損失誘電体を使用する必要があります。選択された値に基づいて、以下の方程式から 1 サイクル(高速)のカレントリミットが 3.2 A 以下に、8 サイクル (低速)のカレントリミットが 1.8 A 以下に設定されます。

$$I_{CL} = \frac{0.5}{\left(\frac{C12}{C26 + C12}\right)(R11)}$$

I<sub>CL</sub> は、8 サイクルのカレントリミット (単位アンペア) です。R11 は、単位がオームです。C26 と C12 は、それぞれ共振コンデンサと電流サンプリング コンデンサの値 (単位ナノファラッド) です。 1 サイクルのカレントリミットについては、上記の方程式の分子で 0.5 V の代わりに 0.9 V を使 用します。

抵抗 R12 とコンデンサ C7 は、IS ピンへの一次電流信号をフィルタします。抵抗 R12 の最大許容抵抗は、220 Ω に設定されています。C7 の値は、ノイズによる誤動作を防ぐために 1 nFに設定されています。ただし、この値は、前述の計算によるカレントリミット設定値に大きく影響するほど高くはありません。これらの部品は、最大の効果が得られるように直接 IS ピンに接続する必要があります。

抵抗 R10 は、デッドタイムを 320 ns に設定します。FEEDBACK (FB) ピンには、この FB ピンに流れる µA あたり 2.6 kHz という近似特性があります。FB ピンへの電流は、U1 の動作周波数を増加させ、出力電圧を軽減します。R8 と R9 の直列接続により、U1 の最小動作周波数が設定されます。一般に、この値は、出力での最大負荷かつ最小整流コンデンサ電圧でのレギュレーションに必要な周波数より少し低く設定されます。抵抗 R8 は C3 によってバイパスされます。これは、フィードバック ループのオープン時に、最初により大きな電流が FB ピンに流れるようにすることによって、起動時の出力ソフトスタートを実現するためです。この結果、スイッチング周波数が高い周波数から始まり、その後、出力電圧がレギュレーションになるまで小さくなります。抵抗 R9 は通常、ソフトスタート時の初期周波数が R10 で設定される最大スイッチング周波数と等しくなるように、R10 と同じ値に設定されます。R9 の値が R10 の値を下回ると、スイッチングの開始の前にディレーが発生します。

フォトカプラ U2 は、IC U1 の FEEDBACK ピンを駆動します。コンデンサ C4 は FB ピンをフィルタします。C4 には 15 nF のコンデンサを使用しています。これは FB ピンでのノイズ カップリングで一次デューティ サイクルの対称性が損なわれるのを回避するためです。通常、C4 の値を非常に高くすると不安定になります。

抵抗 R22 によってフォトカプラに負荷がかかり、バースト モード時に大信号過渡応答が高速化されます。推奨される値は  $4.7 \text{ k}\Omega$  までです。フォトカプラのカットオフが発生した場合、ダイオード D4 によって R22 が R8 に負荷をかけるのを防ぎます。抵抗 R23 によって PSU の ESD 及びサージの耐性が改善されます。また、バースト モード出カリップル電圧も改善されます。フォトカプラが飽和し、FB ピンが 2.0 V である場合、最大値は FB ピン電流が DT/BF ピン電流に等しくなるようにする必要があります (PIXIs HiperLCS 計算シートを参照)。これは、フィードバック ループでスイッチング周波数が  $F_{\text{STOP}}$  を下回ることができなかったために HiperLCS が起動モードを終了しない場合、 $F_{\text{MAX}}$  でバーストして軽負荷で制御できるようにするためです。

バーストモード時にパワー伝送部で ZVS の部分的消失 (不完全な ZVS) が発生することがあります。大半のスイッチング パルスで ZVS が失われると、効率性が犠牲になります。入力及び負荷の範囲によっては、効率が著しく低下する場合があります。これは、バースト デューティサイクルが高く (15 ~ 30%)、パルスの大部分で ZVS の損失が著しい場合に発生し、高い入力電圧に対し負荷が軽くなった時 (たとえば 420 VDC で負荷が 1%) に悪化する傾向があります。 ZVC の損失が、デバイスの加熱、シャットダウン、損傷につながることがあります。デッドタイムを低下 (FMAX を上昇) させたり、FSTART を上昇させたりすると状況が悪化します。これは、さらに高い動作周波数によってトランス励磁電流が低下し、MOSFET 出力容量 (Coss) を充電及び放電するトランスに蓄積されるエネルギーが少なくなるためです。現実の設計では PFC 出力電圧が際限なく異常に高い値にとどまることはありませんが、負荷変動の場合は短時間で定格値に戻ります。これは、バーストモードでの ZVS 損失を確認する際に考慮すべきは最大定格PFC 出力電圧のみであることを示しています。

### 5.2 出力整流

トランス T2 の出力は、ダイオード D2 と D3、そしてコンデンサ C14 と C15 で整流及びフィルタ されます。これらのコンデンサは X5R 誘電体であり、出力リップル電流定格規格値があり、慎重 に選ばれています。このアプリケーションでは、標準 Z5U 誘導体コンデンサの使用は困難です。 追加の出力フィルタは、L1、L2、C16、C23 によって行われます。抵抗 R13、R20、R18 は、U3 基準電圧とともに、電源の出力電圧を設定します。12 V 出力がレギュレーション全体を支配するように電圧センス抵抗が設定されます。エラー アンプ U3 は、R14 経由でフィードバック フォトカプラ U2 を駆動します。部品 C17-19 及び R14-17 は、コンバータのゲイン位相特性を決定します。



#### その他の情報

スマートフォンと <u>www.neoreader.com</u> の 無料ソフトウェア (またはお使いのスマート フォンのアプリケーション ストアにあるその 他の無料 QR コード リーダー) を使用して、 当社 Web サイトの関連コンテンツに接続し てください。

# 6 PCB レイアウト

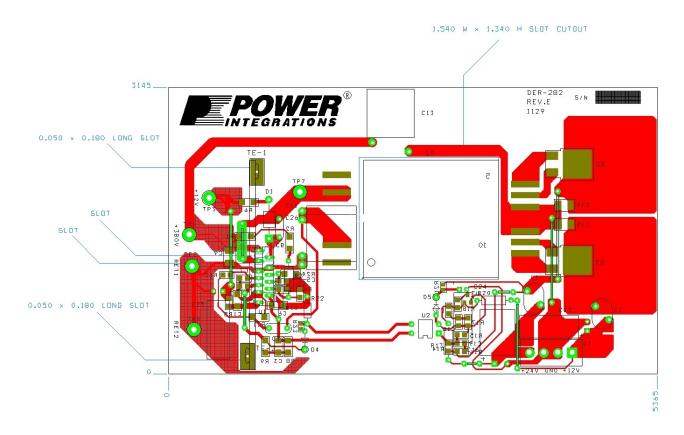


図4-基板レイアウト

#### 7 部品表

項目	数量	参照略号	概要	製造部品番号	製造
1	2	C1 C6	1 μF、25 V、セラミック、X7R、1206	C3216X7R1E105K	TDK
2	1	C2	4.7 nF、200 V、セラミック、X7R、0805	08052C472KAT2A	AVX
3	1	C3	470 nF、100 V、セラミック、X7R、1206	C3216X7R2A474K	TDK
4	1	C4	15 nF、50 V、セラミック、X7R、0805	ECJ-2VB1H153K	Panasonic
5	1	C5	4.7 nF、50 V、セラミック、X7R、0805	ECJ-2VB1H472K	Panasonic
6	1	C7	1 nF、50 V、セラミック、X7R、0805	ECJ-2VB1H102K	Panasonic
7	1	C8	330 nF、50 V、セラミック、X7R	B37984M5334K000	Epcos
8	1	C9	22 nF、630 V、セラミック、X7R、1210	GRM32QR72J223KW01L	Murata
9	1	C12	47 pF、1,000 V、ディスク セラミック	561R10TCCQ47	Vishay
10	1	C13	2.2 nF、セラミック、Y1	440LD22-R	Vishay
11	2	C14 C15	10 μF、35 V、セラミック、X5R、1210	GMK325BJ106KN-T	Taiyo Yuden
12	1	C16	220 μF、35 V、電解、低 ESR、90 mΩ、(8 x 15)	ELXZ350ELL221MH15D	Nippon Chemi-Con
13	1	C17	22 nF、200 V、セラミック、X7R、0805	08052C223KAT2A	AVX
14	1	C18	2.2 nF、200 V、セラミック、X7R、0805	08052C222KAT2A	AVX
15	1	C19	2.2 nF、50 V、セラミック、X7R、0805	ECJ-2VB1H222K	Panasonic
16	2	C23 C25	220 μF、16 V、電解、低 ESR、180 mΩ、(6.3 x 15)	ELXZ160ELL221MF15D	Nippon Chemi-Con
17	1	C24	10 μF、50 V、電解、汎用、(5 x 11)	EKMG500ELL100ME11D	Nippon Chemi-Con
18	1	C26	3.3 nF、1,600 V、フィルム	B32652J1332J	Epcos
19	1	D1	600 V、1 A、超高速リカバリー、75 ns、DO-41	UF4005-E3	Vishay
20	1	D2	60 V、7.5 A、ショットキー、SMD、DPAK	STPS15L60CB-TR	ST
21	1	D3	45 V、7.5 A、デュアル ショットキー、TO-252AA (D-PAK)	STPS15L45CB-TR	ST
22	2	D4 D5	75 V、300 mA、高速スイッチング、DO-35	1N4148TR	Vishay
23	1	ESIPCLIP M4 METAL1	ヒートシンク ハードウェア、エッジ クリップ、 長さ 20.76 mm x 幅 8 mm x 厚さ 0.015 mm	NP975864	Aavid Thermalloy
24	1	GREASE1	サーマル グリース、シリコン、5 オンス チューブ	CT40-5	ITW Chemtronics
25	1	HS1	ヒートシンク、カスタム、アルミニウム、3003、 厚さ 0.62		Custom
26	1	J1	4 ポジション (1 x 4) ヘッダー、0.156 ピッチ、垂直	26-48-1045	Molex
27	4	JP1 JP2 JP3 JP4	ジャンパー線、[テフロンなど高熱] 絶縁、#22 AWG、 1 インチ	2855/1 WH005	AlphaWire
28	2	JP5 JP6	ジャンパー線、[テフロンなど高熱] 絶縁、#22 AWG、 0.5 インチ	2855/1 WH005	AlphaWire
29	2	JP7 JP8	ジャンパー線、[テフロンなど高熱] 絶縁、#22 AWG、 0.25 インチ	2855/1 WH005	AlphaWire
30	2	L1 L2	536 nH、電力用T型巻鉄心、2ピン、出力		
31	1	NUT1	ナット、六角、Kep 4-40、S ZN Cr3 メッキ RoHS	4CKNTZR	任意の RoHS 指令 適合製造
32	2	R1 R2	976 kΩ、1%、1/4 W、厚膜、1206	ERJ-8ENF9763V	Panasonic
33	1	R3	976 kΩ、1%、1/4 W、メタル フィルム	MFR-25FBF-976K	Yageo
34	1	R4	20 kΩ、1%、1/8 W、厚膜、0805	ERJ-6ENF2002V	Panasonic
35	1	R5	4.7 Ω、5%、1/8 W、厚膜、0805	ERJ-6GEYJ4R7V	Panasonic
36	1	R6	2.2 Ω、5%、1/4 W、厚膜、1206	ERJ-8GEYJ2R2V	Panasonic
37	1	R8	31.6 kΩ、1%、1/4 W、厚膜、1206	ERJ-8ENF3162V	Panasonic
38	1	R9	7.32 kΩ、1%、1/4 W、厚膜、1206	ERJ-8ENF7321V	Panasonic
39	1	R10	7.32 kΩ、1%、1/4 W、メタル フィルム	MFR-25FBF-7K32	Yageo
40	1	R11	20 Ω、5%、1/4 W、厚膜、1206	ERJ-8GEYJ200V	Panasonic

www.powerint.com

41	1	R12	220 Ω、5%、1/8 W、厚膜、0805	ERJ-6GEYJ221V	Panasonic
42	1	R13	887 kΩ、1%、1/4 W、メタル フィルム	MFR-25FBF-887K	Yageo
43	1	R14	9.1 kΩ、5%、1/8 W、厚膜、0805	ERJ-6GEYJ912V	Panasonic
44	2	R15 R16	1 kΩ、5%、1/8 W、厚膜、0805	ERJ-6GEYJ102V	Panasonic
45	1	R17	470 kΩ、5%、1/8 W、厚膜、0805	ERJ-6GEYJ474V	Panasonic
46	1	R18	10 kΩ、1%、1/8 W、厚膜、0805	ERJ-6ENF1002V	Panasonic
47	1	R20	42.2 kΩ、1%、1/4 W、メタル フィルム	MFR-25FBF-42K2	Yageo
48	1	R21	10 kΩ、5%、1/10 W、厚膜、0603	ERJ-3GEYJ103V	Panasonic
49	1	R22	4.7 kΩ、5%、1/8 W、カーボン フィルム	CFR-12JB-4K7	Yageo
50	1	R23	3.6 kΩ、5%、1/10 W、厚膜、0603	ERJ-3GEYJ362V	Panasonic
51	1	R24	66.5 kΩ、1%、1/4 W、厚膜、1206	ERJ-8ENF6652V	Panasonic
52	1	SCREW1	SCREW MACHINE PHIL 4-40 X 1/4 SS	PMSSS 440 0025 PH	Building Fasteners
53	1	T2	カスタム トランス、EFD30、Horz、 10 ピン (1 次側 4 x 2 次側 6)		Power Integrations
54	1	TE1 TE2	丸形板端子、錫プレート黄銅、Zierick PN 190	190	Zierick
55	1	TP1	試験点、黄、スルーホール実装	5014	Keystone
56	2	TP2 TP4	試験点、黒、スルーホール実装	5011	Keystone
57	1	TP3	試験点、赤、スルーホール実装	5010	Keystone
58	1	TP7	試験点、白、スルーホール実装	5012	Keystone
59	1	U1	HiperLCS、ESIP16/13	LCS700HG	Power Integrations
60	1	U2	フォトカプラ、35 V、CTR 80 ~ 160%、4 DIP	LTV-817A	Liteon
61	1	U3	IC, REG ZENER SHUNT ADJ SOT-23	LM431AIM3/NOPB	National Semi
62	1	WASHER1	平ワッシャー #4 SS	FWSS 004	Building Fasteners

# トランスの仕様

#### 回路図 8.1

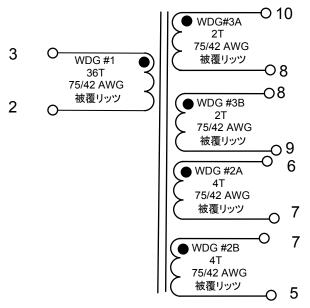


図5-トランスの回路図

### 8.2 電気仕様

耐電圧	1 秒間、60 Hz、3 ~ 2 から 6 ~ 10 まで	500 VAC
一次インダクタンス	他の巻線をすべてオープンした状態でピン 3 ~ 2 を 100 kHz、0.4 V <sub>RMS</sub> で測定	440 μH ±5%
共振周波数	ピン3~2、他の巻線をすべてオープンした状態	1400 kHz (最小)
一次漏れインダクタンス	ピン 5、6、7、8、9、10 をショートした状態で、ピン 3 ~ 2 を 100 kHz、0.4 V <sub>RMS</sub> で測定	100 μΗ

### 8.3 材料

項目	概要
[1]	コア: EFD30 Ferroxcube 3F3 材料またはそれと同等の製品。
[2]	ボビン: EFD30 垂直、10 ピン、(1 次側 4 x 2 次側 6) カスタム SMT ボビン。
[3]	テープ:ポリエステル ウェブ:3M #44 またはそれと同等の製品、3.0 mm 幅。
[4]	テープ:ポリエステル フィルム 3M 1350F-1 またはそれと同等の製品、12.2 mm 幅。
[5]	テープ:ポリエステル フィルム 3M 1350F-1 またはそれと同等の製品、5 mm 幅。
[6]	マグネット ワイヤ:75/#42 単層コート被覆リッツ線。
[7]	トランスのワニス Dolph BC-359 またはそれと同等の製品。

注:安全要件に適合するよう、一部のアプリケーションではトランスを再設計する必要がある場合があります。

## 8.4 トランスの構造図

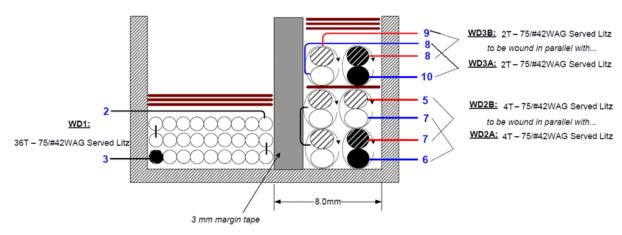


図6ートランスの構造図

# 8.5 ボビン – ピン番号

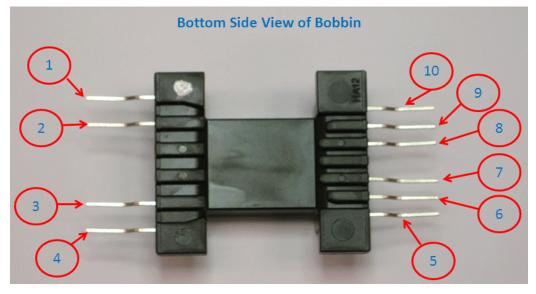


図7ーボビンのピン番号

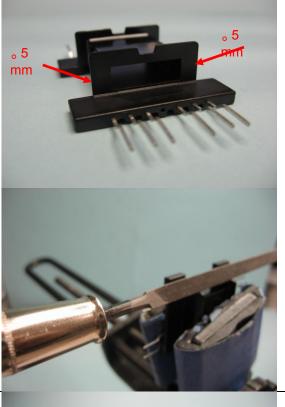
# 8.6 トランス構造

巻線の準備	コアを適切に装着するには、細いコース ファイルを使用し、約 0.5 mm のボビン材料を一次側及び二次側にある短いフランジから削除します。図のようにボビンの右側にマージン テープ [3] を貼ります。ボビンの右側からテープの左側の 8 mm になるところに貼り付けてください。
WD1 (一次側)	図に示されている位置から始めて、リッツ線 [6] をボビン左側に 36 回、3 層巻き付けます。テープ [4] 1 層で巻線を固定します。
二次巻線の準備	リッツ線項目 [6] の長さ 15 インチのストランドを 2 本準備します。このストランドの終端を錫メッキし、各終端に 1 インチの長さを残しながら、2 本のストランド全体を均等に最大 65 回ツイストして 1 本にします。このケーブルは一方が 6 及び 7、他方が 7及び 5 となります。
WDG2A 及び WDG2B (二次側)	図のように 6 と 7 から始め、マージン テープとボビン右側の間のセクションで 4 回巻き付け、図のように 7 と 5 で終了します。
絶縁	テープ [5] を 1 回巻き付けて固定します。
二次巻線の準備	リッツ線 [6] の長さ 7.5 インチのストランドを 2 本準備し、このストランドの終端を錫メッキします。各終端に 1 インチの長さを残しながら、ストランド全体を均等に最大30 回ツイストして 1 本にします。このケーブルは一方が 10 及び 8、他方が 8 及び9 となります。
WDG3A 及び WDG3B	図のように 10 と 8 から始め、マージン テープとボビン右側の間のセクションで 2 回
(二次側)	巻き付け、図のように8と9で終了します。
絶縁	テープ項目 [5] を 1 層貼り、巻線を固定します。
終了	ピン 2 と 3 の間で 440 µH ±5% のインダクタンスを実現するために、一方のコアのセンター レッグを研磨します。センター レッグが研磨されたコアを使い、ボビンの一次側でコアの両半分を組み立てます。(項目 [7]) に浸漬ワニスをします。

www.powerint.com

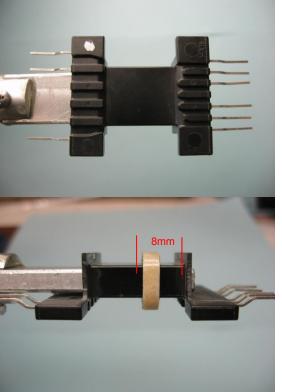
## 8.7 巻線の図

#### ボビンの準備



コアの両半分を適切に装着す るには、細いコースファイルを 使用し、約 0.5 mm のボビン材 料を一次側及び二次側にある 短いフランジから削除します。

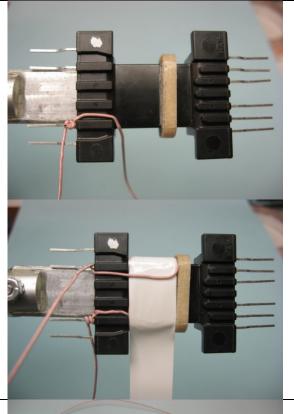
バリア テープ



ボビン項目 [2] を巻線軸に配 置し、ピン 1 が左側になるよう にします。

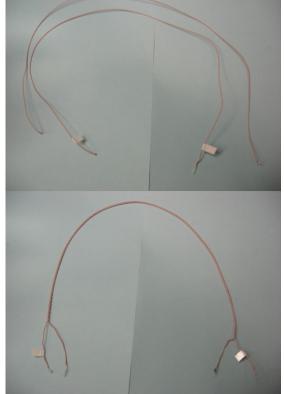
二次側フランジから 8 mm の 位置に、3 mm のバリア テー プ [3] を 20 回巻き付けます。 テープの高さは、ボビンフラン ジの高さと同一である必要が あります。

WD1 (一次側)



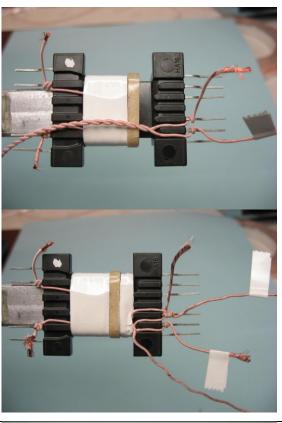
ピン3から始めて、被覆リッ ツ線 [6] を 3 層で 36 回巻き 付け、ピン2で終了します。 テープ [4] を 3 回巻き付けて 巻線を固定します。

WD2 の準備



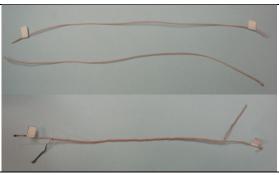
被覆リッツ線 [6] のストランド 2 本を、それぞれ 15 インチの 長さに切断します。リッツ線の 1 本のストランドを、テープや 他の種類のマーキング材料で マークします。最大 65 回ツイ ストして2本のストランドを1本 にします。各終端に約1インチ 残します。

### WD2A 及び WD2B (二次側)



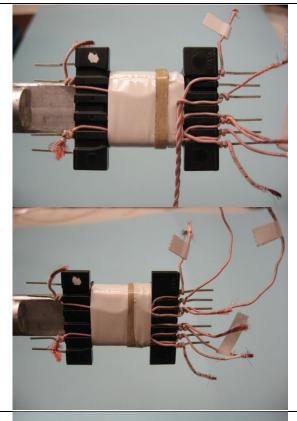
前のステップで準備した被覆リッツ組み立てを使用して、ピン6でマークされている端ピン7でマークされていない端から始め、4回巻き付けます。ピン7でマークされている端とピン5でマークされていない端で終了します。テープに10を1回巻き付けて巻線を固定します。

#### WD3 の準備



被覆リッツ線 [6] のストランド2 本を、それぞれ7 インチの長さに切断します。リッツ線の1 本のストランドを、テープや他の種類のマーキング材料でマークします。最大30 回ツイストして2 本のストランドを1 本にします。各終端に約1 インチ残します。

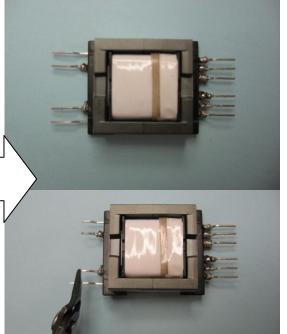




前のステップで準備した被覆リッツ組み立てを使用して、ピン 10 でマークされている端とピン 8 でマークされていない端から始め、2 回巻き付けます。ピン 8 でマークされている端とピン 9 でマークされていない端で終了します。テープ[5]を3回巻き付けて巻線を固定します。

#### 終了

センター レッグが 研磨されたコアを、 ボビンの左側に挿 入します。



線の終端をすべてはんだ付け します。

ピン 2 と 3 の間で 440 µH ±5% のインダクタンスを実現するために、コアの一方 [1] のセンターレッグを研磨します。センターレッグが研磨されたコアと研磨されていないコアを使い、固定します。

各ボビン ピンから 3.5 mm 切り取ります。

終了 (続き)



[7] に浸漬ワニスをします。

# 9 出力インダクタの仕様

インダクタ L1 及び L2 はそれぞれ、Micrometals T30-26 鉄心トロイダル コアで #22 AWG マ グネット ワイヤを 4 回巻き付けたものです。

### 9.1 電気仕様

インダクタンス	他の巻線をすべてオープンした状態で、ピン FL1 ~ FL2 を	536 nH、±15%
10,7,7,000	100 kHz、0.4 V <sub>RMS</sub> で測定	330 III 1, ± 13 /0

### 9.2 材料リスト

項目	概要
[1]	鉄心トロイダル コア: Micrometals T30-26
[2]	マグネット ワイヤ:#22 AWG はんだ付け可能な 2 層コーティング

# 10 LLC 共振コンバータ設計計算シート

HiperLCS_041311; Rev.1.0; Copyright Power Integrations 2011	入力	情報	出力	単位	HiperLCS_041311_Rev1-0.xls、HiperLCS ハーフブリッジ、連続モード LLC 共振コンパータ設計計算シート
入力パラメータの入力	•	!	-		
VBULK_NOM			380	V	定格 LLC 入力電圧
Vbrownout			280	V	停止スレッシュホールド電圧。電圧がこの値を下回ると、HiperLCS がシャットダウンします。許容値は VBULK_NOM の 65 ~ 76% です。保持時間に対しては 65% に設定します
Vbrownin			353	V	整流コンデンサの起動スレッシュホールド
VOV shut			465	V	整流電圧の OV 保護
VOV_restart			448	V	OV 保護の後のリスタート電圧
CBULK			69	uF	保持時間要求に合わせた整流コンデンサの最小値。 保持時間と Vbulkmin を調整して、整流コンデンサ の値を変更します
tHOLDUP			21.8	ms	整流コンデンサ保持時間
LLC (二次) 出力の入力					計算シートでは、二次側の AC 積み上げと想定されます
VO1	12.00		12.0	V	メイン出力電圧。計算シートでは、安定化出力と想定 されます
IO1	2.32		2.3	Α	メイン出力最大電流
VD1	0.60		0.60	V	メイン出力のダイオードの順方向電圧
PO1			28	W	メイン LLC 出力からの出力電力
VO2	24.00		24.0	V	第二出力電圧
IO2	3.00		3.0	Α	第二出力電流
VD2	0.60		0.60	V	第二出力で使用されるダイオードの順方向電圧
PO2			72.00	W	第二 LLC 出力からの出力電力
P_LLC			100	W	指定された総 LLC 出力電力
LCS デバイスの選択					
デバイス	自動		LCS700		LCS デバイス
RDSON (最大)			2.78	Ω	選択したデバイスの RDSON (最大)
Coss			125	pF	選択したデバイスの等価 Coss
Cpri			40	pF	トランスの一次側の浮遊容量
PCOND_LOSS			1.3	W	公称電圧及び最大負荷での導通損失
TMAX_HS			90	deg C	最大ヒートシンク温度
Theta J-HS			10.1	deg C/W	ヒートシンクへの熱抵抗ジャンクション (グリース使用、絶縁体なし)
推定ジャンクション温度			103	deg C	推定ジャンクション温度
Ta 最大			50	deg C	推定最大周囲温度
Theta HS-A			31	deg C/W	周囲に対する必要な熱抵抗ヒートシンク
LLC 共振パラメータとトラ	シスの計算 (す	ト色の曲線	を生成)		
Po			103	W	ダイオード損失を含む LLC コンバータからの出力
Vo			12.60	V	トランス巻線のメイン出力 (ダイオード降下を含む)
f_target			250	kHz	PFC 及び LLC に必要な最大負荷時スイッチング周波数。66 ~ 300 kHz、250 kHz を推奨
Lpar			340	uH	並列インダクタンス。(Lpar = Lopen - Lres (一体型トランスの場合)、Lpar = Lmag (漏れが小さい非一体型トランスの場合))
Lpri	440.00		440	uH	ー体型トランスの一次オープン回路インダクタンス。 漏れの小さいトランスの場合は、一次インダクタンス と直列インダクタの和になります。空白のままにした 場合、自動計算によって、80% の Vnom における ZVS の損失に必要な値が示されます

					一体型トランスの直列インダクタンスまたは一次漏れ
Lres	100.00		100.0	uН	インダクタンス。空白にした場合、K=4 の自動計算が
					行われます
					Lpar と Lres の比率。2.1 < K < 11 になるように K
Kratio			3.4		の値を維持します。推奨される Lres は、K < 7 のよ
					うになります
					直列共振コンデンサ。背景が赤のセルは、赤のグラ
				_	フで表されます。Lpar、Lres、Cres、及び
Cres	3.30		3.3	nF	n_RATIO_red_graph が空白の場合は、自動計算
					が行われます
					メイン出力の1つの位相の二次側インダクタンス。
Lsec			1.358	uH	測定して値を入力するか、測定された値と一致する
Lacc			1.000	uii	ように f_predicted を調整します
					漏れ分布係数 (一次と二次)。99% は、漏れの多くが
m			50	%	, , ,
			45.00		一次側にあることを示します
n_eq			15.82		LLC 等価回路の最適なトランスの巻線比
Npri	36.0		36.0		一次巻数。入力しない場合、デフォルト値が自動計
ľ					算されて、f_predicted = f_target となります
Nsec	2.0		2.0		二次巻数 (メイン出力の各位相)。 デフォルト値は
11000	2.0		2.0		BAC<=2000 ガウスを維持するための推定値です。
f predicted			247	kHz	定格入力電圧と最大負荷での推定周波数。n_Ratio
1_predicted			241	KI IZ	及び一次巻線に大きく影響されます
f roo			277	l/U⇒	直列共振周波数 (直列インダクタンス Lres 及び C
f_res			277	kHz	で定義)
f_brownout			192	kHz	VBULK_MIN、最大負荷でのスイッチング周波数
f_par			132	kHz	並列共振周波数 (Lpar + Lres 及び C で定義)
'					Vbrownout 及び最大負荷での最小周波数。
					HiperLCS の最小周波数をこの値に設定します。
f_inversion			179	kHz	この周波数を下回る動作は、ゲイン反転領域で動作
					しなくなります
					低周波ゲインか反転する前の LLC コンバータの最
Vinversion			252	V	小入力電圧。最適な値は Vbrownout と等価です
RMS 電流及び電圧					17775 电注。
	I				最大負荷及び定格入力電圧 (Vbulk) と
IRMS_LLC_Primary			0.68	Α	fnominal_actual での一次巻線 RMS 電流
巻線 1 (二次低電圧側)					moninal_actual Cop   欠巨線 Nino 电流
RMS 電流			4.1	Α	巻線 1 (二次低電圧側) RMS 電流
二次低電圧側コンデン					
			1.1	Α	二次低電圧側コンデンサ RMS 電流
サ RMS 電流					
巻線 2 (二次高電圧側)			2.3	Α	巻線 2 (二次高電圧側) RMS 電流
RMS 電流					
二次高電圧側コンデン			1.4	Α	二次高電圧側コンデンサ RMS 電流
サ RMS 電流				, ,	
Cres Vrms			133	V	最大負荷及び定格入力電圧での共振コンデンサ AC
			100		RMS 電圧
仮想トランス トライアル -	- (青色の曲線	を生成)			
新規一次巻線			36.0		トライアルトランス一次巻線。デフォルト値は共振セ
利克-人名称			30.0		クションの値です
÷r.+0 — >			0.0		トライアルトランス二次巻線。デフォルト値は共振セ
新規二次巻線			2.0		クションの値です
+-10.					トライアルトランスオープン回路インダクタンス。デフ
新規 Lpri			440	uH	オルト値は共振セクションの値です
					直列コンデンサのトライアル値(空白にした場合、
			3.3	nF	
新規 Cres	3.30		5.5	* * * *	f res = f target となるように計管値が選択されます)
	3.30				f_res = f_target となるように計算値が選択されます)
新規推定 Lres	3.30		100.0	uH	トライアルトランスの推定 Lres
新規推定 Lres 新規推定 Lpar	3.30		100.0 340	uH uH	トライアルトランスの推定 Lres トライアルトランスの Lpar の推定値
新規推定 Lres	3.30		100.0	uH	トライアルトランスの推定 Lres

÷r+=/*//=================================				
新規等価回路トランス 巻線比		15.82		推定実効トランス巻線比
新規 V パワー伝送部 逆転		252	V	整流コンデンサの電圧。この値を下回ると、ZVS が 損失します
f_res_trial		277	kHz	新規直列共振周波数
f_predicted_trial		247	kHz	新規定格動作周波数
		0.00		最大負荷及び定格入力電圧 (Vbulk) と
IRMS_LLC_Primary		0.68	Α	f_predicted_trial での一次巻線 RMS 電流
巻線 1 (低二次電圧) RMS 電流		4.1	А	半正弦波形と推定した場合の、出力 1 巻線を流れる RMS 電流。出力 2 巻線は、出力 1 巻線への AC 積 み上げ
低二次電圧コンデンサ RMS 電流		1.1	А	二次低電圧側コンデンサ RMS 電流
巻線 2 (高二次電圧) RMS 電流		2.3	А	出力 2 巻線を流れる RMS 電流
高二次電圧コンデンサ RMS 電流		1.4	А	二次高電圧側コンデンサ RMS 電流
トランス コアの計算 (共振	ミパラメータ セクション	ノからの計算)	1	
トランスコア	自動	EFD30		トランス コア
Ae		0.7	cm^2	トランスコア断面積を入力します
Ve		4.7	cm^3	コアの体積を入力します
Aw		52.3	mm^2	巻線領域
Bw		20.1	mm	合計ボビン幅
損失密度		200.0	mW/cm^3	スイッチング周波数及び BAC での単位体積あたり の損失を入力します (kW/m^3 と同じ単位)
MLT		3.7	cm	1巻あたりの平均長
N_CHAMBERS		2.0		ボビン セクションの数
W_SEP		3.0	mm	巻線仕切り距離 (巻線領域が失われます)
電力ロス		0.9	W	推定コア損失
Bpkfmin		119	mT	最小周波数での第1象限ピーク磁束密度。
BAC		185	mT	AC ピークツー ピーク磁束密度 (f_predicted、及び 最大負荷の Vbulk で計算)
一次巻線				AND COUNTY OF THE CHILDREN
Npri		36.0		一次巻線数。LLC 共振セクションで決定されます
一次ゲージ	42	42	AWG	一次巻線に使用される個別の巻線ゲージ
等価の一次測定基準 巻線ゲージ		0.060	mm	メトリック単位系による等価の線径
一次リッツ ストランド	75	75		リッツ線のストランド数。リッツ線以外の一次巻線の 場合は 1 に設定します
一次巻線分配係数		50	%	一次領域の分配係数 (一次側に割り当てられた巻線 スペースの割合)
AW P		22	mm^2	一次側の巻線領域
 占有率		57%	%	一次巻線の占有率 (%) (標準的な占有率は 60%)
Resistivity_25 C Primary		79.06	mΩ/m	メートルあたりの抵抗率
一次 DCR 25 C		105.25	mΩ	25 C での抵抗の推定値
一次 DCR 100 C		141.03	mΩ	100 C での抵抗の推定値 (25 C の場合よりもおよそ 33% 高くなります)
一次 RMS 電流		0.68	А	一次巻線を流れる測定された RMS 電流
ACR_Trf_Primary		225.65	mΩ	測定された AC 抵抗 (100 kHz、室温) で、1.33 を掛けると、100 C での巻線の温度に近似します
一次銅損		0.11	W	85 C での一次巻線合計銅損
二次巻線 1 (二次低電圧	側または単出力)			注 - 電力損失の計算は、二次側の各巻線の半分に対して行われます
出力電圧		12.00	V	出力電圧 (AC 積み上げ巻線を想定)
セクション 1 の巻線		2.00		二次巻数 (各位相)
セクション 1 の RMS 電流 (AC + DC の		4.1	А	半正弦波形と推定した場合の、出力 1 巻線を流れる RMS 電流。出力 2 巻線は、出力 1 巻線への AC 積
合計)				み上げ

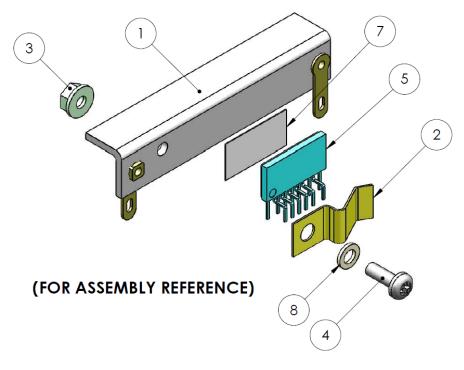
****** (0.0 ****************************		0.00		* 44 = 1
巻線電流 (DC 部品)		2.66	Α	巻線電流の DC 部品
巻線電流 (AC RMS		3.17	Α	巻線電流の AC 部品
部品)		-		
セクション 1 の巻線	42	42	AWG	- 二次巻線に使用される個別の巻線ゲージ
ゲージ				71843 [X118] 1 - 0   Extra   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
等価の二次側 1 の測		0.060	mm	メトリック単位系による等価の線径
定基準巻線ゲージ		0.000		
セクション 1 のリッツ	75	75		リッツ線に使用されるストランド数。リッツ線以外の非
ストランド	70			ー体型トランスの場合は 1 に設定します
Resistivity_25 C_sec1		79.06	mΩ/m	メートルあたりの抵抗率
DCR_25C_Sec1		5.85	mΩ	25 C での位相あたりの抵抗の推定値 (参照用)
DCR_100C_Sec1		7.84	mΩ	100 C での位相あたりの抵抗の推定値 (25 C の場
DCIN_100C_Sec1		7.04	11122	合よりもおよそ 33% 高くなります)
DCR_Ploss_Sec1		0.44	W	DC 抵抗による推定電力損失 (両方の二次位相)
				測定された位相あたりの AC 抵抗 (100 kHz、室温)
ACD Cool		12.54	mΩ	で、1.33 を掛けると、100 C での巻線の温度に近似
ACR_Sec1		12.54	11122	します。ACR のデフォルト値は、100 C での DCR
				値の 2 倍です
ACR_Ploss_Sec1		0.25	W	推定 AC 銅損 (両方の二次位相)
巻線 1 銅損合計		0.70	W	両方の二次位相の合計 (AC + DC) 巻線銅損
コンデンサ RMS 電流		1.1	Α	出力コンデンサ RMS 電流
Co1	10.00	10.0	uF	二次側 1 の出力コンデンサ
コンデンサ リップル				二次側 1 の出力コンデンサのピーク ツー ピーク リッ
電圧		1.2	%	プル電圧
				注一電力損失の計算は、二次側の各巻線の半分
二次巻線 2 (高二次電圧	)			に対して行われます
 出力電圧		24.00	V	出力電圧 (AC 積み上げ巻線を想定)
			•	二次巻線数 (各位相)。二次巻線 1 に重なる AC 積
セクション 2 の巻線		2.00		み上げ
セクション 2 の RMS				
電流 (AC + DC の		2.3	Α	出力 2 巻線を流れる RMS 電流
合計)				
巻線電流 (DC 部品)		1.5	Α	巻線電流の DC 部品
巻線電流 (AC RMS				WATER AND THE
部品)		1.8	Α	巻線電流の AC 部品
セクション 2 の巻線		_		
ゲージ	42	42	AWG	二次巻線に使用される個別の巻線ゲージ
等価の二次側2の測				
定基準巻線ゲージ		0.060	mm	メトリック単位系による等価線径
セクション 2 のリッツ ス				リッツ線に使用されるストランド数。リッツ線以外の非
トランド	75	75		一体型トランスの場合は 1 に設定します
Resistivity_25 C_sec2		79.06	mΩ/m	メートルあたりの抵抗率
トランス二次 MLT		3.70	cm	1巻あたりの平均長
DCR_25C_Sec2		5.85	mΩ	25 C での位相あたりの抵抗の推定値 (参照用)
				100 C での位相あたりの抵抗の推定値 (25 C の場
DCR_100C_Sec2		7.84	mΩ	合よりもおよそ 33% 高くなります)
DCR Ploss Sec1		0.14	W	DC 抵抗による推定電力損失 (両方の二次巻線)
				測定された位相あたりの AC 抵抗 (100 kHz、室温)
			_	で、1.33を掛けると、100 C での巻線の温度に近似
ACR_Sec2		12.54	mΩ	します。ACR のデフォルト値は、100 C での DCR
				値の2倍です
ACR_Ploss_Sec2		0.08	W	推定 AC 銅損 (両方の二次巻線)
巻線2銅損合計		0.22	W	両方の二次巻線の合計 (AC + DC) 巻線銅損
コンデンサ RMS 電流		1.4	A	出力コンデンサ RMS 電流
Co2	10.00	10.0	uF	二次側2の出力コンデンサ
コンデンサ リップル	. 5.00			二次側 1 の出力コンデンサのピークツーピークリッ
電圧		0.8	%	プル電圧
光工				ノル尼江

トランス損失の計算				ギャップからのフリンジング磁束損失は含まない
一次銅損(一次セク				イヤッフからのフリンフング版末頂大は音まない
ションから)		0.11	W	85 C での一次巻線合計銅損
二次銅損		0.92	W	二次卷線合計銅損
トランスの合計銅損		1.02	W	トランスの合計銅損 (一次 + 二次)
AW_S		22.25	mm^2	二次巻線の領域
_		22.20	111111 2	二次巻線の占有率(%)。標準的な最大占有率は、
二次占有率		13%	%	一次を終められて (70)。 標準的な最大られては、 被覆リッツ線で 60%、裸リッツ線で 75% です
信号ピン抵抗値				
デッドタイム		320	ns	デッドタイム
バースト モード	自動	2		バースト モードとして、1、2、及び3を選択します。 これらにはヒステリシスがあり、周波数スレッシュ ホールドが異なります
f_max		797	kHz	デッドタイム設定に応じた最大内部クロック周波数
f_burst_start		299	kHz	バーストモードの下側スレッシュホールド周波数で、 ヒステリシスを設定します。これは、バーストオフ期間後の再起動時のスイッチング周波数です
f_burst_stop		349	kHz	バースト モードの上側スレッシュホールド周波数。 これは、バースト オフ期間が停止した時点のスイッ チング周波数です
DT/BF ピン上側分割 抵抗		7.21	kΩ	DT/BF ピンから VREF ピン間の抵抗
DT/BF ピン下側分割 抵抗		65	kΩ	DT/BF ピンから G ピン間の抵抗
Rstart	7.32	7.32	kΩ	起動抵抗 - ソフトスタート コンデンサと直列接続される抵抗。起動時の FB から VRFF ピン間の抵抗値と等価
起動ディレー		0.0	ms	起動ディレー。スイッチング開始前の遅延です。遅延 を増やすには、R_START の値を下げます
Rfmin		31.8	kΩ	VREF ピンから FB ピン間の抵抗で、最小動作周波数を設定します。この抵抗と Rstart によって f_MINが決まります
C_softstart	1	1.0	uF	ソフトスタート コンデンサ。推奨値は、0.1 ~ 10 uF です
Ropto		3.8	kΩ	フォトカプラ エミッタと直列接続される抵抗
OV/UV ピン下側抵抗	20.00	20.0	kΩ	OV/UV ピン分割回路の下側抵抗
OV/UV ピン上側抵抗		2.92	ΜΩ	OV/UV ピン分割回路の上側抵抗
LLC コンデンサの分割電	流センス回路	<b>.</b>		
低速カレント リミット		1.91	Α	8 サイクル カレント リミット - 停止及び起動中の正の ハーフサイクルをチェックします
高速カレント リミット		3.44	A	1 サイクル カレント リミット - 起動中の正のハーフサ イクルをチェックします
LLC センス コンデンサ		47	pF	HV センス コンデンサ。メインの共振コンデンサと共 に電流分割器を形成します
RLLC センス抵抗	20	18.6	Ω	LLC 電流センス抵抗。センスコンデンサの電流を検出します
IS ピン カレント リミット 抵抗		220	Ω	センス R の電圧が -0.5 V 未満の場合のセンス抵抗 から IS ピンへの電流を制限します
IS ピン ノイズ フィルタ コンデンサ		1.0	nF	IS ピン バイパス コンデンサ。IS ピンのカレント リミット コンデンサと共に極を形成します
IS ピン ノイズ フィルタ ポール周波数		724	kHz	このポールは IS ピン信号を減衰します
損失量	,	<b>'</b>		
LCS デバイスの導通 損失		1.3	W	公称電圧及び最大負荷での導通損失
担力ダイオード損失		1.4	W	
トランスの推定合計			VV	正んプログースへ
銅損		1.02	W	トランスの合計銅損 (一次 + 二次)

. = > ¬ の#☆∧=! −		Ī	
トランスの推定合計コ ア損失	0.9	W	推定コア損失
合計トランス損失	2.0	W	合計トランス損失
<b>合計</b> 推定 <b>損失</b>	4.7	W	LLC 段の合計損失
推定効率	96%	%	推定効率
ピン	104	W	LLC 総入力電力
二次巻線と電圧センタリング計算機		これは、二次巻線を選択する場合に役に立ちます。 出力は計算シートの他のどの部分にも接続されてい ません	
V1	12.00	V	目標安定化出力電圧 Vo1。変更してスレーブ出力への影響を確認します
V1d1	0.60	V	Vo1 のダイオード降下電圧
N1	2.00		Vo1 の合計巻線数
V1_Actaul	12.00	V	推定出力
V2	24.00	V	目標出力電圧 Vo2
V2d2	0.60	V	Vo2 のダイオード降下電圧
N2	4.00		Vo2 の合計巻線数
V2_Actual	24.60	V	推定出力電圧
外付け直列インダクタ (非一体型ト	<u> </u>		一体型磁性部品を使用している場合は適用されません。計算シートの他のどの部分にも接続されていません
Lsep	100.00	uH	外付けインダクタの必要なインダクタンス
Ae_Ind	0.53	cm^2	インダクタコア断面積
インダクタ巻数	13		一次側巻数
BP_fnom	1501	ガウス	コア損失計算の AC 磁束 (f_predicted 及び最大負荷の場合)
推定ピークー次電流	1.9	Α	推定ピークー次電流
BP_fmin	2802	ガウス	最小周波数 fmin で計算されたピーク磁束密度
インダクタ ゲージ	44	AWG	一次巻線に使用される個別の巻線ゲージ
等価のインダクタ測定 基準巻線ゲージ	0.050	mm	メトリック単位系による等価の線径
インダクタ リッツ スト ランド	125.00		リッツ線で使用されるストランド数
インダクタ並列巻線	1		リッツ線を構成するための個別の並列巻線数
Resistivity_25 C_Sep_Ind	75.4	mΩ/m	メートルあたりの抵抗率
A MAANUT			4 # t t I O TI I E
インダクタ MLT	7.00	cm	1 巻あたりの平均長
インダクタ ML I インダクタ DCR 25 C	7.00 68.6	mΩ	25 C での抵抗の推定値 (参照用)
		_	25 C での抵抗の推定値 (参照用) 100 C での抵抗の推定値 (25 C の場合よりもおよそ 33% 高くなります)
インダクタ DCR 25 C	68.6	mΩ	25 C での抵抗の推定値 (参照用) 100 C での抵抗の推定値 (25 C の場合よりもおよそ

注:二次巻線の計算シートの計算では、出力巻線の AC 積み上げを想定しています。この設計のトランス構造では、 AC 積み上げが使用されていませんでした。

# 11 ヒートシンク アセンブリ



項目#	項目の概要
1	ヒートシンク
2	メタル クリップ
3	六角形ナット
4	ネジ
5	HiperLCS IC
6	なし
7	サーマル グリース
8	平ワッシャー

図8 - 組み立て前

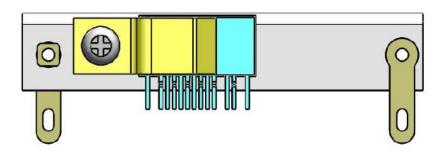


図9-組み立て後



# 12 性能データ

### 12.1 効率性 - 100%、50%、20%、及び 10% の負荷

### 12.1.1 効率データ

P <sub>IN</sub>	V <sub>OUT</sub> (24 V)	I <sub>OUT</sub> (24 V)	V <sub>OUT</sub> (12 V)	Ι <sub>ουτ</sub> (12 V)	P <sub>OUT</sub>	効率 (%)
107.05	24.27	2.999	11.99	2.327	100.686	94.06
53.97	24.24	1.503	11.99	1.164	50.389	93.36
22.365	24.22	0.6027	11.99	0.4608	20.122	89.97
11.985	24.22	0.3027	11.99	0.2266	10.048	83.84

### 12.2 出力クロス レギュレーション

下の図のデータ取得のため、1 つの出力は最大負荷 (3 A) に固定され、他の出力は合計出力 電力が一貫して 100 W となるように調整しました。

### 12.2.1 クロス レギュレーション データ

3 A 時に	こ 12 V でのク	ロス レギュレ・	ーション	3 A 時に	24 V でのク	ロス レギュレー	ーション
V <sub>OUT</sub> (24 V)	Ι <sub>ουτ</sub> (24 V)	V <sub>OUT</sub> (12 V)	I <sub>оит</sub> (12 V)	V <sub>OUT</sub> (24 V)	I <sub>OUT</sub> (24 V)	V <sub>OUT</sub> (12 V)	I <sub>o</sub> (12 V)
25.31	0.0105	11.94	3	22.84	3	12.07	0.012
25.25	0.0206	11.94	3	23.21	3	12.05	0.02
25.21	0.0318	11.94	3	23.28	3	12.05	0.0314
25.16	0.0514	11.95	3	23.35	3	12.04	0.0507
25.08	0.1024	11.95	3	23.46	3	12.04	0.1008
24.98	0.2506	11.95	3	23.64	3	12.03	0.251
24.9	0.5014	11.96	3	23.79	3	12.02	0.4997
24.78	0.9992	11.96	3	23.96	3	12.01	1.0016
24.6	2	11.97	3	24.21	3	11.99	2.001
24.49	2.645	11.98	3	24.29	3	11.99	2.324

### 12.3 起動時及びシャットダウン時の整流電圧

VCC 入力に +12 VDC が適用され、出力起動電圧は 357.4 VDC、出力シャットダウンは 283.9 VDC で行われました。

# 13 波形

## 13.1 通常動作時のハーフブリッジ電圧とハーフブリッジ電流

## 13.1.1 380 VDC 入力で測定

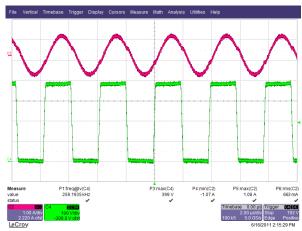


図 10 - 一次側 V-I、最大負荷

上:一次電流、1 A/div

下: HB から 1 次側グラウンド電圧へ、

100 V, 2 μs/div

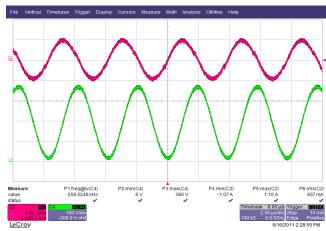


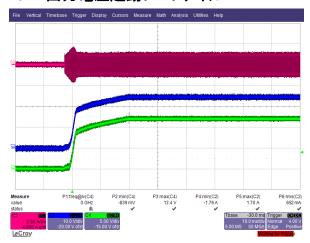
図 11 - 一次側 V-I、最大負荷

上:一次電流、1 A/div

下: 共振コンデンサ (C11) 電圧、

100 V, 2  $\mu$ s/div

## 13.2 出力電圧起動プロファイル

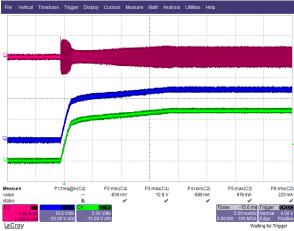


### 図 12 - 最大負荷での起動

上:一次電流、1 A/div

中:24  $V_{OUT}$ 、10 V/div

下: 12  $V_{OUT}$ 、5 V、10 ms/div



### 図 14 - 起動時の最大電圧、無負荷時

上:一次電流、1 A/div

中: 24 V<sub>OUT</sub>、10 V/div 下: 12 V<sub>OUT</sub>、5 V、5 ms/div

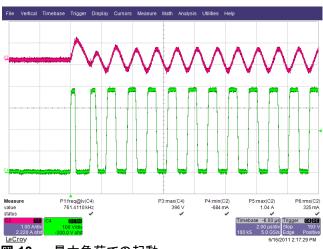


図 13 - 最大負荷での起動

上:一次電流、1 A/div

下: HB から1次側グラウンド電圧へ、

100 V, 2 μs/div

### 13.3 負荷過渡応答 (380 VDC 入力時に 5% から 100% の負荷)

次の図では、信号平均化を使用して、負荷過渡応答波形を見やすくしました。トリガ ソースとして負荷電流ステップを使用して、オシロスコープをトリガしました。出力スイッチングと入力周波数は基本的に負荷過渡応答に関してランダムに発生するので、これらのソースからの出力リップルに対する影響は平均化し、負荷ステップ応答からの影響のみが残ります。

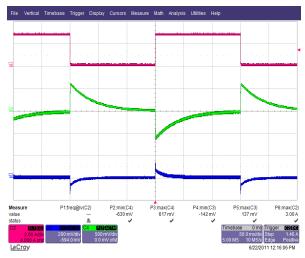


図 **15** - 24 V<sub>OUT</sub> で 5% ~ 100% の負荷過渡 応答、12 V<sub>OUT</sub> で 10% の負荷。

上:24 V<sub>OUT</sub> 負荷電流、2 A/div

中:24 V<sub>OUT</sub> AC 結合、500 mV/div

下: 12 V<sub>OUT</sub> AC 結合、200 mV/div、

50 mS/div

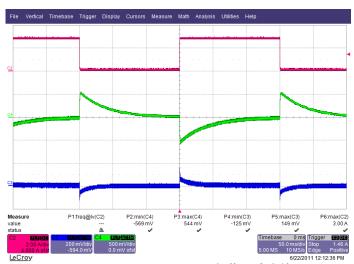


図 16 - 24 Vout で 5% ~ 100% の負荷過渡応答、

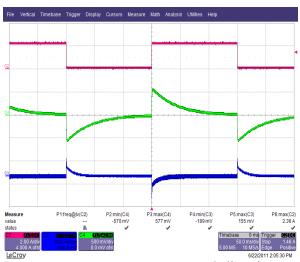
12 Vour で 100% の負荷。

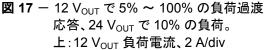
上:24 V<sub>OUT</sub> 負荷電流、2 A/div

中:24 VOUT AC 結合、500 mV/div

下: 12 Vout AC 結合、200 mV/div、

50 mS/div





中:24 V<sub>OUT</sub> AC 結合、500 mV/div 下:12 V<sub>OUT</sub> AC 結合、200 mV/div、

50 mS/div

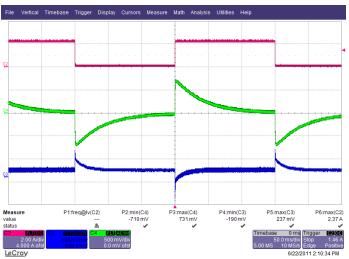


図 18 - 12 V<sub>OUT</sub> で 5% ~ 100% の負荷過渡応答、

24 V<sub>OUT</sub> で 100% の負荷。 上:12 V<sub>OUT</sub> 負荷電流、2 A/div

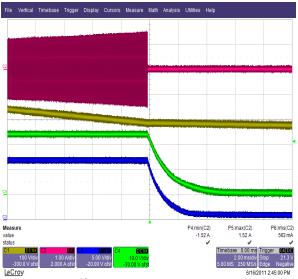
中:24 V<sub>OUT</sub> AC 結合、500 mV/div

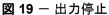
下: 12 V<sub>OUT</sub> AC 結合、200 mV/div、

50 mS/div

### 13.4 出力停止

図 12 と 13 は、入力電圧電源をオフにして、24 V 出力の立ち下がりエッジでオシロスコープを トリガ。





上:一次電流、1 A/div

2番目のトレース: 一次側バス電圧、

100 V/div

3 番目のトレース: 24 V<sub>OUT</sub>、10 V/div

4番目のトレース: 12 V<sub>OUT</sub>、5 V、2 ms/div

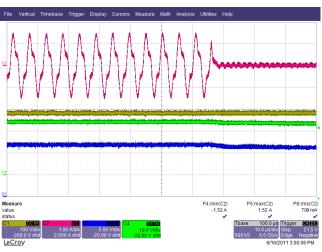


図 20 - 出力停止

上:一次電流、1 A/div

2番目のトレース: 一次側バス電圧、

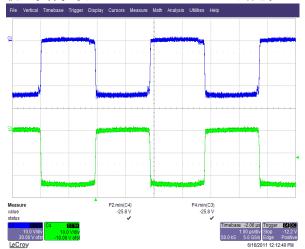
100 V/div

3 番目のトレース: 24 Vout、10 V/div

4番目のトレース: 12 V<sub>OUT</sub>、5 V、10 μs/div

### 13.5 出力ダイオードピーク逆電圧

最大負荷時及び 380 VDC 入力で測定。



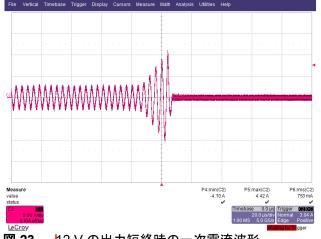
P2:min(C4) -51.7 V

図 21 - 12 V 出力ダイオード (D3 デュアル パッケージ共通カソード)、 380 VDC 入力、10 V、1 μs/div

図 22 - 24 V 出力ダイオード (D2 デュアル パッケージ共通カソード)、 380 VDC 入力、20 V、1 μs/div

### 13.6 短絡

次に示すテストでは、100 W 負荷、380 VDC 入力で、出力端子を水銀リレーでショートしました。 オシロスコープは、電流の立ち上がりでトリガするように設定。



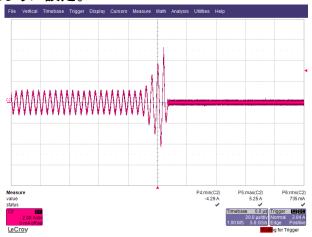


図 23 - 12 V の出力短絡時の一次電流波形、 2 A、20 μs/div

図 24 - 24 V の出力短絡時の一次電流波形、 2 A, 20 μs/div

### 13.7 出カリップルの測定

### 13.7.1 リップルの測定方法

DC 出力リップル測定で、干渉による信号の影響を減らすには、オシロスコープ テストのプローブを修正する必要があります。プローブ修正の詳細を下の図に示します。

4987BA プローブ アダプタにはコンデンサが 2 つ付いており、プローブの先端に並列で接続されます。このコンデンサは、一方 (1) が 0.1 μF/50 V セラミック タイプで、もう一方 (1) が 1.0 μF/50 V アルミニウム電解コンデンサです。アルミニウム電解コンデンサは有極です。したがって、DC 出力に対して正しい極性を維持する必要があります (下の写真を参照)。

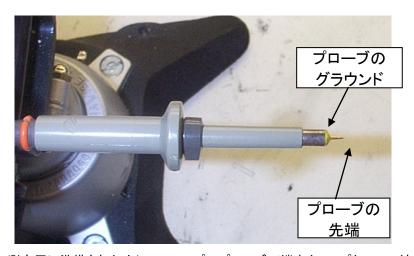


図 25 - リップル測定用に準備されたオシロスコープのプローブ。(端末キャップとアース線を取り外したところ)



図 26 - オシロスコープのプローブと Probe Master (<u>www.probemaster.com</u>) 4987A BNC アダプタ。 (リップル測定用ワイヤが変更され、2 つの並列デカップリング コンデンサが追加された)

# 13.7.2 出力リップルの測定結果



図 27 - 12 V<sub>RIPPLE</sub>、380 VDC、最大負荷 50 mV,  $2 \mu \text{s} / \text{div}$ 



図 29 - 12 V<sub>RIPPLE</sub>、380 VDC、無負荷 50 mV, 200  $\mu$ s/div (電源はバーストモードではありません。)

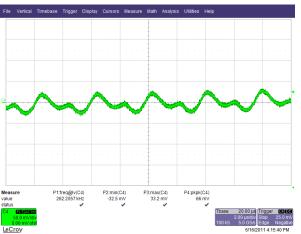


図 28 - 24 V<sub>RIPPLE</sub>、380 VDC、最大負荷 50 mV 2 μs/div

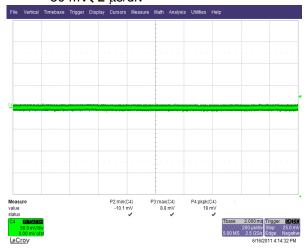


図 30 - 24 V<sub>RIPPLE</sub>、380 VDC、無負荷 50 mV/div 200 μs/div (電源はバーストモードではありません。)

## 14 温度測定

# 14.1 条件:380 VDC、最大負荷、1 時間動作

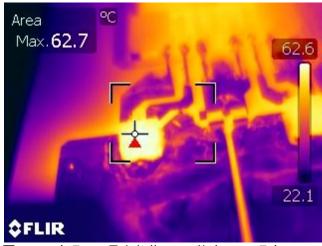


図 31 - 室温での最大負荷 24 V 整流 (D2) 温度の 上面表示

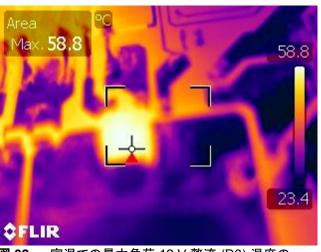


図 32 - 室温での最大負荷 12 V 整流 (D3) 温度の 上面表示



図 33 - 室温での最大負荷トランス (T1) の温度表示

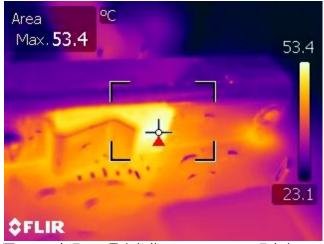


図 34 - 室温での最大負荷 HiperLCS (U1) 温度表示



図 35 - ボードの上面

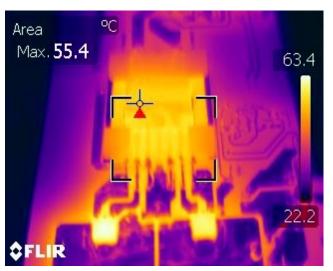


図 36 - ボードの底面

# 15 改訂履歴

日付	作成者	改訂	説明と変更点	校閲者
2011年9月13日	SS	1.2	初回リリース	アプリケーション担
				当とマーケティング
				担当

### For the latest updates, visit our website: www.powerint.com

Power Integrations reserves the right to make changes to its products at any time to improve reliability or manufacturability. Power Integrations does not assume any liability arising from the use of any device or circuit described herein. POWER INTEGRATIONS MAKES NO WARRANTY HEREIN AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

#### PATENT INFORMATION

The products and applications illustrated herein (including transformer construction and circuits' external to the products) may be covered by one or more U.S. and foreign patents, or potentially by pending U.S. and foreign patent applications assigned to Power Integrations. A complete list of Power Integrations' patents may be found at <a href="https://www.powerint.com">www.powerint.com</a>. Power Integrations grants its customers a license under certain patent rights as set forth at <a href="https://www.powerint.com/ip.htm">https://www.powerint.com/ip.htm</a>.

The PI Logo, TOPSwitch, TinySwitch, LinkSwitch, DPA-Switch, PeakSwitch, CAPZero, SENZero, LinkZero, HiperPFS, HiperTFS, HiperLCS, Qspeed, EcoSmart, Clampless, E-Shield, Filterfuse, StackFET, PI Expert and PI FACTS are trademarks of Power Integrations, Inc. Other trademarks are property of their respective companies. ©Copyright 2011 Power Integrations, Inc.

### **Power Integrations Worldwide Sales Support Locations**

#### **WORLD HEADQUARTERS**

5245 Hellyer Avenue San Jose, CA 95138, USA. Main: +1-408-414-9200 Customer Service: Phone: +1-408-414-9665 Fax: +1-408-414-9765

e-mail: usasales@powerint.com

#### **CHINA (SHANGHAI)**

Rm 1601/1610, Tower 1 Kerry Everbright City No. 218 Tianmu Road West Shanghai, P.R.C. 200070 Phone: +86-021-6354-6323 Fax: +86-021-6354-6325 e-mail: chinasales@powerint.com

#### CHINA (SHENZHEN)

Rm A, B & C 4<sup>th</sup> Floor, Block C, Electronics Science and Technology Building 2070 Shennan Zhong Road Shenzhen, Guangdong, P.R.C. 518031 Phone: +86-755-8379-3243 Fax: +86-755-8379-5828 e-mail: chinasales@powerint.com

#### **GERMANY**

Rueckertstrasse 3 D-80336, Munich Germany Phone: +49-89-5527-3911 Fax: +49-89-5527-3920 e-mail: eurosales@powerint.com

#### INDIA

#1, 14<sup>th</sup> Main Road Vasanthanagar Bangalore-560052 India Phone: +91-80-4113-8020 Fax: +91-80-4113-8023 e-mail: indiasales@powerint.com

#### **ITALY**

Via De Amicis 2 20091 Bresso MI Italy Phone: +39-028-928-6000 Fax: +39-028-928-6009 e-mail: eurosales@powerint.com

#### **JAPAN**

Kosei Dai-3 Building 2-12-11, Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033 Japan

Phone: +81-45-471-1021 Fax: +81-45-471-3717 e-mail: japansales@powerint.com

#### **KOREA**

RM 602, 6FL Korea City Air Terminal B/D, 159-6 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-728 Korea Phone: +82-2-2016-6610

e-mail: koreasales@powerint.com

Fax: +82-2-2016-6630

#### SINGAPORE

51 Newton Road, #19-01/05 Goldhill Plaza Singapore, 308900 Phone: +65-6358-2160 Fax: +65-6358-2015 e-mail: singaporesales@powerint.com

#### **TAIWAN**

5F, No. 318, Nei Hu Rd., Sec. 1 Nei Hu District Taipei 114, Taiwan R.O.C. Phone: +886-2-2659-4570 Fax: +886-2-2659-4550 e-mail: taiwansales@powerint.com

#### **EUROPE HQ**

1st Floor, St. James's House East Street, Farnham Surrey GU9 7TJ United Kingdom Phone: +44 (0) 1252-730-141 Fax: +44 (0) 1252-727-689 e-mail: eurosales@powerint.com

#### APPLICATIONS HOTLINE

World Wide +1-408-414-9660

#### APPLICATIONS FAX

World Wide +1-408-414-9760

